

中国半导体行业协会半导体分立器件分会

中半器协 [2017]004 号

第三届全国新型半导体功率器件及应用技术研讨会

第二轮通知

自 2017 年 7 月 1 日中国半导体行业协会以“中半器协[2017]003 号”文发出《第三届全国新型半导体功率器件及应用技术研讨会》以来，来自全国各地的产、学、研等单位大力支持，积极投稿，现会议的准备工作已经就绪，就会议细节和论文录用情况通知如下：

畅通、共享、共赢——全球化背景下的新型半导体器件及应用技术

一、会议特邀报告

1. 后 IGBT 时代的技术研发与产业化战略思考

株洲中车时代电气股份有限公司副总工程师 刘国友 教授

2. 待定

浙江大学电气工程学院 盛况 教授

3. 待定

南京银茂微电子制造有限公司总经理 庄伟东 博士

4. 集成功率器件与隔离技术的进展

电子科技大学微电子与固体电子学院 李泽宏 教授

5. SiC MOSFET-技术、器件和应用

英飞凌科技中国有限公司工业功率控制事业部高级经理 陈子颖 先生

6. 氮化镓毫米波器件进展

专用集成电路重点实验室副主任 冯志红 研究员

7. 氮化镓功率电子器件及其应用

苏州捷芯威半导体有限公司总裁 裴轶 博士

二、会议组织机构

指导单位：中国半导体行业协会

主办单位：中国半导体行业协会分立器件分会

株洲中车时代电气股份有限公司

承办单位：新型功率半导体器件国家重点实验室

专用集成电路重点实验室

河北普兴电子科技股份有限公司
中国电子科技集团公司第十三研究所

协办单位：合肥锐拓科技信息服务有限公司
长沙欧信会议服务有限公司
《半导体技术》编辑部
《微纳电子技术》编辑部

三、会议时间和地点

1 会议时间：2017 年 11 月 24 日报到，25 日至 27 日开会。

2 会议地点：长沙雅士亚华美达广场酒店，长沙市雨花区万家丽中路 199 号。距长沙高铁南站约 7 公里，距长沙黄花国际机场约 25 公里。

四、会议日程

1. 此次《研讨会》共录用论文（或论文摘要）99 篇（见附件），其中特邀报告 7 篇，全部特邀报告和论文摘要（或论文）都已经收入《论文集》，并将在参会者到会报到时发给每位参会者。希望每篇论文摘要（或论文）至少有一位作者参加会议。

由于研讨会时间有限，我们将根据具体情况选择安排在会上作报告的论文，并在会前与作者沟通。

2. 11 月 24 日在长沙雅士亚华美达广场酒店报到，11 月 25-26 日开会。会议议程安排如下：

时 间	地 点	主 题
11 月 25 日上午	长沙雅士亚华美达广场 酒店（6 楼牡丹厅会议室）	开幕式；特邀报告
11 月 25 日下午		特邀报告；大会报告
11 月 26 日上午		大会报告
11 月 26 日下午		大会报告

3. 11 月 27 日机动。

会议联系单位：中国半导体行业协会半导体分立器件分会秘书处

（石家庄市合作路 113 号 中国电子科技集团公司第十三研究所）

联系人：陆 皓 手机：13832163057 电子邮件：luhao4168@vip.126.com

李 永 电话：0311-87091519 手机：13933075237

传 真：0311-87091477

电子邮件：polaris13@vip.163.com

半导体分立器件分会信箱：csiadd@126.com

中国半导体行业协会半导体分立器件分会
二零一七年十月二十八日



附件一：研讨会录用论文摘要（或论文）目录 （按论文摘要收录时间为序）

序号	作者姓名	工作单位	论文题目
1	吴坚	上海华庆焊材技术有限公司	IGBT 半导体功率器件预成型无铅焊片研究
2	谭开洲	模拟集成电路重点实验室	一种可制造的新型电荷不敏感高压器件结构
3	郑翔	北京工业大学	GaN 基 HEMT 器件的陷阱分析及表征技术
4	马腾	中国科学院新疆理化技术研究所	高能重离子引起的部分耗尽 SOI 器件潜在可靠性降低的研究
5	吴昊	中国电子科技集团公司第二十四研究所	一种抗总剂量加固型 UMOS 器件
6	陈晓娟	长春理工大学电子信息工程学院	三电平逆变器故障诊断方法研究
7	江南	中国科学院宁波材料技术与工程研究所	CVD 单晶金刚石合成及其应用
8	张明敏	中国电子科技集团公司第二十四研究所	基于结型场效应功率管的高性能运算放大器设计
9	李全春	GaN Systems Inc.	GaN Systems 氮化镓器件特性及其应用
10	王万礼	天津环鑫科技发展有限公司	一种沟槽形貌的优化方法及应用
11	张兴尧	中国科学院新疆理化技术研究所	不同偏置下 InP DHBT 电离总剂量效应与退火效应
12	王力	上海坤道信息技术有限公司	利用亚微米级别分辨率的反射率热成像技术对功率半导体器件进行热测试
13	成兴明	江苏华海诚科新材料股份有限公司	高导热环氧塑封料的研究
14	王斌	西安电子科技大学	A Novel Holographic Antenna Based on SPiN Diodes at 60 GHz
15	张军亮	福建晋润半导体技术有限公司	屏蔽栅沟槽功率 MOSFET 的进展及应用
16	张强	哈尔滨工业大学材料科学与工程学院	热管理用超高导热金刚石/Al 复合材料
17	傅蔡安	江南大学	大功率 IGBT 铝碳化硅散热基板超高热等静压制备工艺的研究
18	傅蔡安	江南大学	铝金刚石复合材料散热基板表面覆铜技术的研究
19	何鑫	北京工业大学	SiC 肖特基二极管封装热阻检测技术的研究
20	石帮兵	北京工业大学	SiC MOS 器件瞬态温升及热阻的测量研究
21	李曼	南京邮电大学	A 3-D Analytical Model of Surface Electric Field for SOI Lateral Super Junction Devices with Non-Equilibrium Concentration
22	徐帅	郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	微波等离子体化学气相沉积单晶金刚石与宽禁带半导体功率器件
23	罗琳	北京工业大学	GaN 基 HEMT 器件的在线测温研究
24	孙国圣	东莞市天域半导体科技有限公司	超高压 4H-SiC 双极性功率器件材料相关问题
25	高巍	电子科技大学微固学院	一种新型三埋层终端结构
26	高巍	电子科技大学微固学院	ITO-220AB 封装功率 VDMOS 器件的热阻特性分析
27	李飞	西安卫光科技有限公司	半导体器件两种结壳热阻测试方法对比研究
28	李飞	西安卫光科技有限公司	半导体器件热阻测试校准系数电流选择方法
29	杨宏春	电子科技大学物理电子学院	高功率光导开关器件

- 30 黄新宇 西南交通大学力学与工程学院 高体积分数 Al/SiC 复合材料的制备工艺和性能研究
- 31 蔡莹 上海华虹宏力半导体制造有限公司 射频横向扩散场效应晶体管的 MIM 电容可靠性优化工艺
- 32 夏自金 贵州振华风光半导体有限公司 基于 FX2110 驱动器的测试可行性分析
- 33 潘嘉 上海华虹宏力半导体制造有限公司 更具有折中优势的 IGBT 器件超级结-绝缘栅双极性晶体管 (SJ-IGBT)
- 34 姜舶洋 北京工业大学 功率 VDMOS 器件结温在线测量的研究
- 35 李秀然 上海华虹宏力半导体制造有限公司 高温炉管内残留的 Trans_LC 对功率器件的影响及一种解决办法
- 36 董妍 电子科技大学物理电子学院 基于 InP 衬底的超快响应的光导开关
- 37 付裕 电子科技大学电子工程学院 金刚石微波功率器件模型研究
- 38 周书星 中国科学院新疆理化技术研究所 HEMT 器件辐照效应的研究进展
- 39 孟昭亮 西安工程大学电子信息学院 一种集成无盲区测量 I_c 功能的 IGBT 模块设计
- 40 易文杰 中国电子科技集团公司第四十八研究所 SiC 高温高能离子注入机的开发、验证及应用
- 41 王福丽 中国科学院半导体研究所 基于新型耦合微腔激光器的波长转换器的实现
- 42 郭春生 北京工业大学 IGBT 模块高温反偏试验实时测温技术研究
- 43 闫宏丽 西安龙腾新能源科技发展有限公司 1200V Trench-FS IGBT 设计
- 44 齐旭东 洛阳单晶硅集团有限责任公司 集成电路用硅衬底片抛光平整度改进的实践与探讨
- 45 齐旭东 洛阳单晶硅集团有限责任公司 不同的干燥工艺条件下水雾控制的研究
- 46 齐旭东 洛阳单晶硅集团有限责任公司 硅衬底表面金属污染的控制与改进
- 47 周铮 株洲中车时代电气股份有限公司 功率器件封装超声键合强度均匀性技术控制研究
- 48 胡晓斌 中国电子科技集团公司第二十四研究所 直流高压开关电源工作原理研究及设计
- 49 吴丽娟 长沙理工大学物理与电子科学学院 PDL 实验室 一种低比导的纵向场板高 K LDMOS
- 50 吴宇芳 南京邮电大学 具有界面电荷层 LDMOS 的 E-SOA 研究
- 51 田超 北京交通大学电气学院 适用大功率 IGBT 的门极驱动过流检测保护方法的研究
- 52 大功率 SiC MOSFET 驱动过流检测与保护问题研究
- 53 张宝林 中国空间技术研究院 星载电源模块 VDMOS 器件并联瞬态电流均衡特性研究
- 54 史一泽 湖南大学电气与信息工程学院 SiC 高温器件及应用的发展现状
- 55 曾程 湖南大学电气与信息工程学院 高压 SiC ETO 器件及其脉冲功率应用研究
- 56 徐政 中国电子科技集团公司第五十八研究所 高速高功率密度硅基氮化镓 (GaN-on-Si) 功率集成技术研究
- 57 杨镓溢 中国电子科技集团公司第二十四研究所 陶瓷基薄膜集成电路高可靠性工艺开发
- 58 程红娟 中国电子科技集团公司第四十六研究所 β -Ga₂O₃ 单晶 Si 掺杂样品分析
- 59 朱慧 北京工业大学 衬底减薄对 AlGa_N/GaN HEMT 电学性能的影响
- 60 纪冬梅 苏州珂晶达电子有限公司 MOSFET 功率管器件三维单粒子烧毁仿真工作及机理研究
- 61 黄彬 重庆中科渝芯电子有限公司 一种双外延超级势垒整流器及其制造方法
- 62 张森 中晟光电设备(上海)股份有限公司 硅基氮化镓功率器件专用设备的开发

- 63 黄先进 北京交通大学电气学院 1700V SiC 功率模块应用于地铁辅助变流器特性研究
- 64 陈明祥 华中科技大学机械科学与工程学院 半导体功率器件封装用新型陶瓷基板技术
- 65 赵明皞 郑州大学 氮化镓压电半导体强度测试装置及实验分析
- 66 熊德赣 湖南浩威特科技发展有限公司 界面相对金刚石颗粒增强铝基复合材料性能的影响
- 67 刘芳 北京智芯微电子科技有限公司 180nm NMOSFET 中浅沟槽隔离对栅电流的影响
- 68 窦海啸 北京智芯微电子科技有限公司 冷热冲击实验对 TSV 可靠性影响及裂纹延展机理研究
- 69 刘晓昱 北京智芯微电子科技有限公司 失效分析技术在高密度封装芯片中的应用研究
- 70 王飞 上海华虹宏力半导体制造有限公司 超级结器件的发展
- 71 李学会 深圳深爱半导体股份有限公司 500V 增强型与耗尽型集成 VDMOS 器件设计
- 72 王平平 哈尔滨工业大学金属复合材料与工程研究所 高导热金刚石/铝复合材料的可靠性研究
- 73 谭坚文 重庆大学电气工程学院 基于 Marx 和 LTD 拓扑的全固态复合模式高压纳秒脉冲源研制
- 74 伍伟 电子科技大学 一种高 K 介质埋层的槽栅 IGBT 器件
- 75 胡飞 中国科学院微电子研究所 MOS 控制晶闸管 (MCT) 的 di/dt 优化设计
- 76 张峻 北京卫星制造厂 军用方形功率器件的旋转缝焊技术研究
- 77 唐林江 北京卫星制造厂 高 k 栅介质材料在新型半导体器件的应用研究
- 78 汪波 中国航天科技集团公司第八研究院第八〇八研究所 基于宇航应用的高可靠抗辐照 VDMOS 产品设计
- 79 李诚瞻 株洲中车时代电气股份有限公司 不同栅电极下 Y_2O_3/Al_2O_3 堆栈 MOS 电容的特性研究
- 80 方子文 AIXTRON China Limited GaN and SiC epitaxial production technologies for high volume manufacturing of efficient power semiconductor devices
- 81 揭佳敏 西安电子科技大学微电子学院 基于碱土金属的 SiC MOS 界面模型的仿真分析
- 82 王莎 西安电子科技大学微电子学院 4H-SiC 基快中子探测器的器件结构设计
- 83 王其超 中国电子科技集团公司第 24 研究所 一种应用于 GaN 功放的电源调制器设计
- 84 陈龙 上海微技术工业研究院 面向产业化应用的 8 英寸硅基 GaN 外延材料
- 85 邱岳 南昌大学 P-AlGaIn 生长速率对 GaN 基黄光 LED 光电性能的影响
- 86 汪炼成 中南大学 Optically-pumped Lasing with Q-factor Exceeding 6000 from Wet-etched GaN Micro-pyramids
- 87 杨帆 上汽大众汽车有限公司 功率器件在新能源汽车中的应用分析
- 88 丁杰钦 中国电子科技集团公司第四十八研究所 SiC 外延生长工艺中三角形缺陷的控制
- 89 汪张超 中国电子科技集团公司第四十三研究所 功率循环下厚膜组装 VDMOS 的焊接层的分析
- 90 刘章发 北京交通大学 基于二路功分器互连和阶梯阻抗变换的超宽带八路功率分配/合成
- 91 吴佳倩 北京交通大学 面向相控阵雷达的低噪声放大器的设计
- 92 邹有彪 安徽富芯微电子有限公司 大通流低压半导体放电管的研制